

BBOP350 - Détecteurs bolométriques pour les bandes 300-500 µm

Assemblée Générale du Labex FOCUS

27/09/2023

LETI: L. Dussopt, H. Kaya, V. Goudon, A. Aliane.

IRFU: L. Rodriguez, V. Revéret.

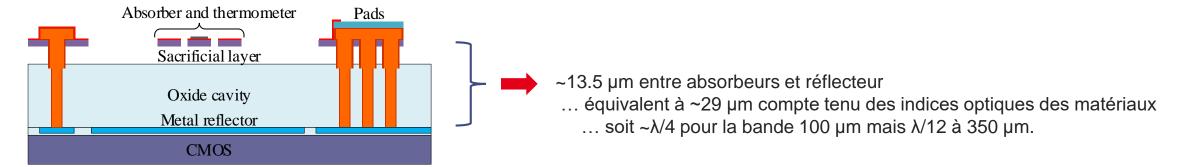




Contexte



- Développement d'une filière de détecteurs polarimétriques en gamme sub-mmtrique dans le cadre du Labex Focus et du prog. SPICA.
- Schéma d'intégration de type Above-IC: Détecteurs sur circuit de lecture CMOS
- Besoin applicatif: bandes 60, 100, 200, 350 µm et au-delà



Coupe techno des détecteurs B-BOP-100µm

- Verrou: ce schéma d'intégration ne permet pas de réaliser une cavité optique quart d'onde classique dimensionnée pour la bande 350 μm.
 - Solution proposée: Surfaces Haute Impédance (HIS) (projet HIS350)

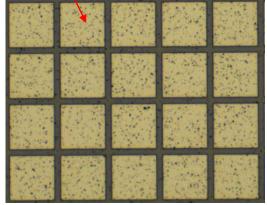
Contexte

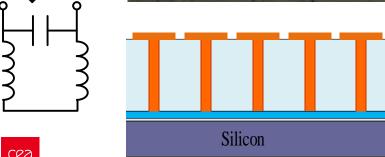
Projet Focus HIS350: Preuve de concept

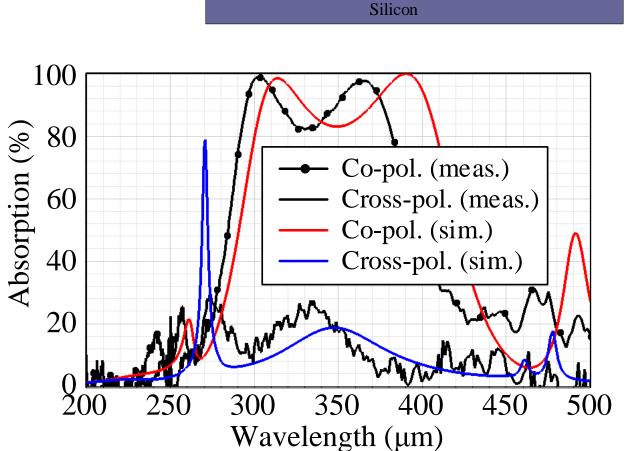
- Prototypes d'absorbeurs représentatifs des détecteurs BBOP.
- Très bonne réponse en absorption à chaud et à froid
- Réponse similaire quelle que soit l'orientation des absorbeurs

Motif élémentaire:

- période 37.5 µm
- gap 4.6 µm
- via Ø 3 µm







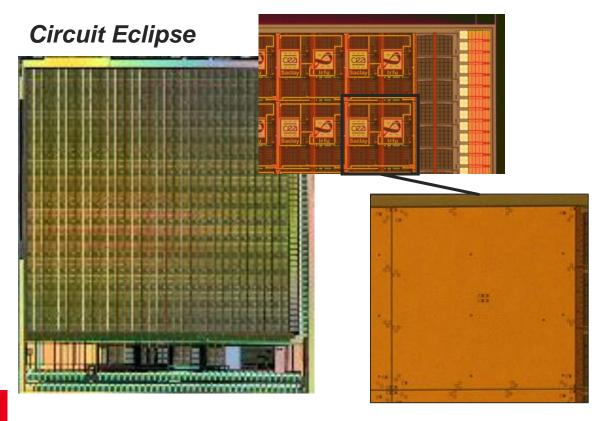


Contexte



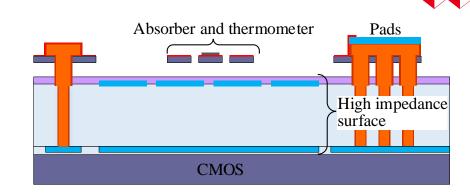
Projet BBOP350: Développement de matrices fonctionnelles

- Spécifications pour un instrument au sol type ArTéMiS
- Circuit de lecture (Eclipse) inchangé: fixe la taille pixel et l'empreinte des connexions circuit-détecteur

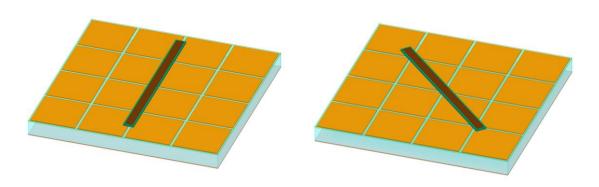


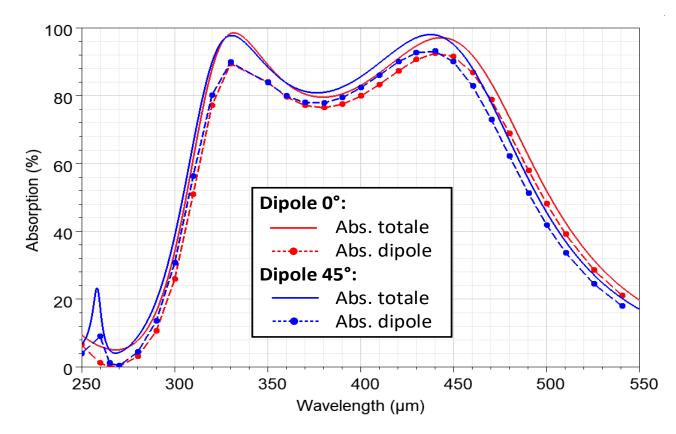
Spécifications					
Taille pixels	750µm				
Bande	300-500µm				
Polarisation	2 polarisations/pixel: 0°/90° et ±45°				
Format	16x16 pixels, aboutage sur 2 bords				
Flux de fond/pixel	20-40 pW				
Temps de réponse	5 ms (~30 Hz)				
NEPphoton	7.5x10 ⁻¹⁷ W/Hz ^{0.5}				
Pjoule	~pW/pixel				
Température	270 mK				

Absorption optique



- **Dimensions** communes pour les 2 types de pixels:
 - O Dipôles: 120x6 μm, 4 ohm/sq.
 - O HIS: période 36,75 μm, gap 2,2 μm
- Bande proche de 50%
 - Pixel 0/90°: 319-507 μm
 - Pixel ±45°: 306-499 μm



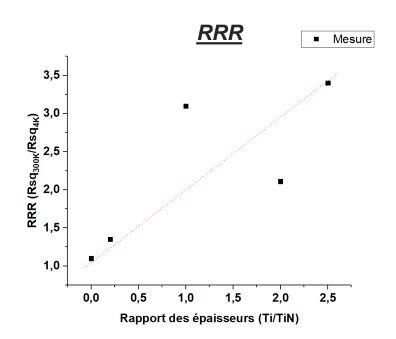


Absorption optique

Films supraconducteurs pour les absorbeurs: bicouche Ti/TiN

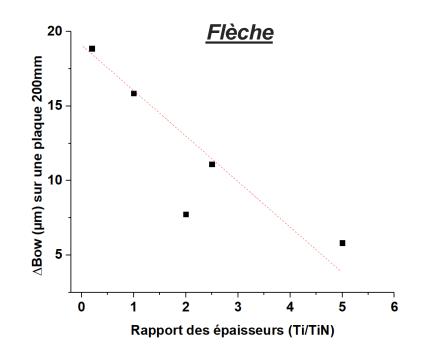
- Objectifs: Résistivité ~3-5 Ω/□ @350 μm, Tc ≥ 0,8 K
- Ajustement des épaisseurs => impact sur Stress, Tc et Résistivité
- Bon compromis : Ti:50nm/TiN:20nm

	7			<u>To</u>	2		■ Me	esure
Tc (K)	4,5	-					- 1016	suic
	4,0 -		Tankanan da					
	3,5		The state of the s	**************************************				
	3,0							
	2,5				The same of the sa			
	2,0					A. A	•	
	1,5					**************************************		
	1,0	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
_		0,0		t des épa			2,0	



P02	P04
Ti/TiN (50nm/20nm) @ 100°C	Ti/TiN (50nm/50nm) @ 100°C
10.44 Ω/□	8.88 Ω/□
2.2-2.3 (K)	3.2-3.25 (K)
3.4	3.1
3.07 Ω/□	2.86 Ω/□
3.21 Ω/□	3.16 Ω/□
	Ti/TiN (50nm/20nm) @ 100°C 10.44 Ω/□ 2.2-2.3 (K) 3.4 3.07 Ω/□

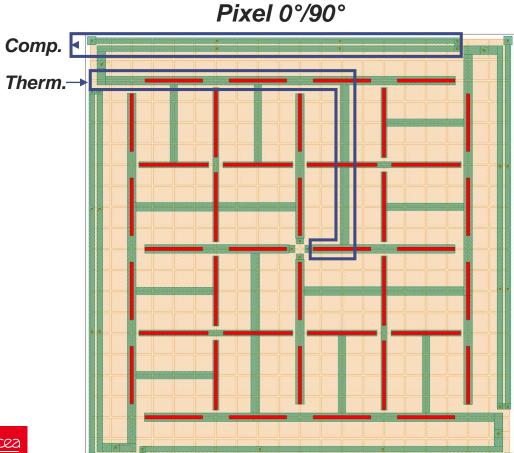
Mesures basse température à l'Institut Néel (C. Winkelmann).

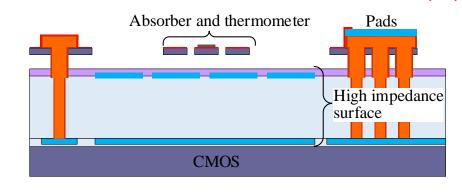




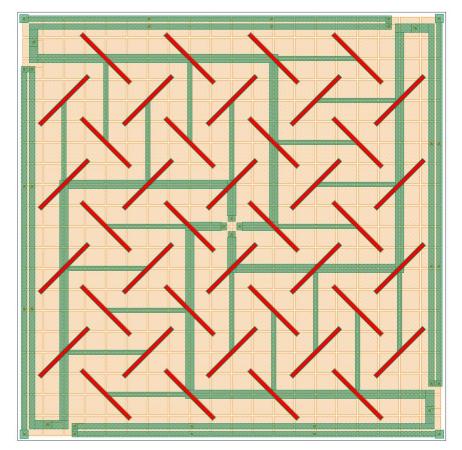
Technologie et Layout

- 4x5 absorbeurs (120x6 µm) dans chaque direction
- Résistances de compensation et thermomètres dimensionnés pour une réponse similaire des 2 pixels





Pixel ±45°



Réponse électro-optique (1)

1) Lecture en pont diviseur de tension

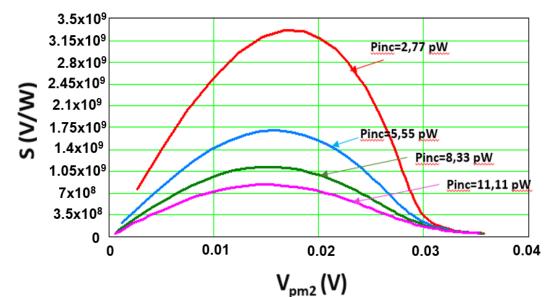
Résist. de compensation (Rc): 10x1200 μm

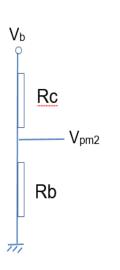
Résist. thermomètre (Rb): 15x800 μm

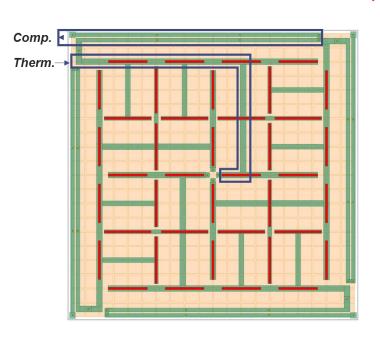
$$R(T) = N_{\square} \cdot R_{0} \cdot exp\left(\sqrt{\frac{T_{0}}{T}}\right)$$

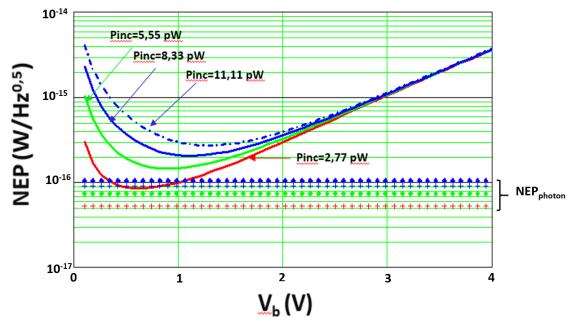
Optimisation à T=300 mK et flux ~5 pW:

- $T_0 = 55K$, $R_0 = 187$ ohm
- Rb=7,5 G Ω , Rc = 17 G Ω (300 mK)
- Sensibilité = 1,7x10⁹ V/W
- NEP totale = $1,45x10^{-16}$ W/Hz^{0,5} @Vb = 900mV











Réponse électro-optique (2)



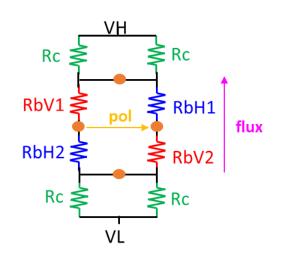
- Résist. de compensation (Rc): 10x1200 μm
- Résist. thermomètre (Rb):

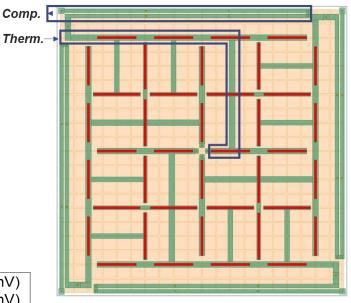
15x800 µm

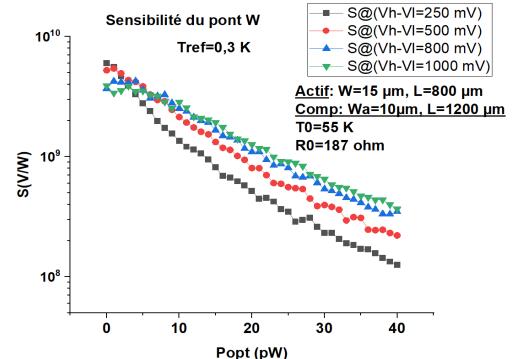
$$R(T) = N_{\square} \cdot R_0 \cdot exp\left(\sqrt{\frac{T_0}{T}}\right)$$

Optimisation à T=300 mK et flux 20 pW:

- $T_0 = 55K$, $R_0 = 187$ ohm
- Rb=7,5 G Ω , Rc = 17 G Ω (300 mK)
- Sensibilité ~ 10⁹ V/W (Vh-VI = 800mV)

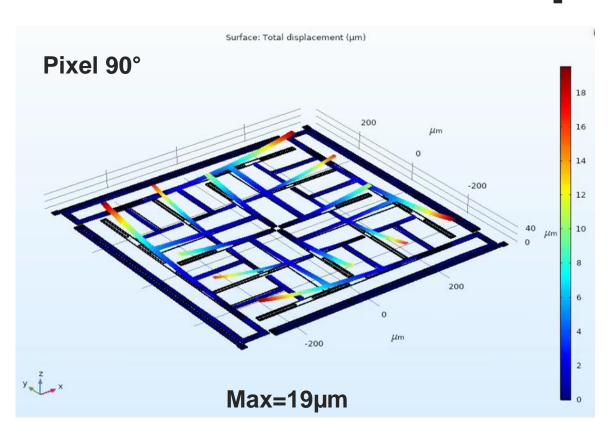






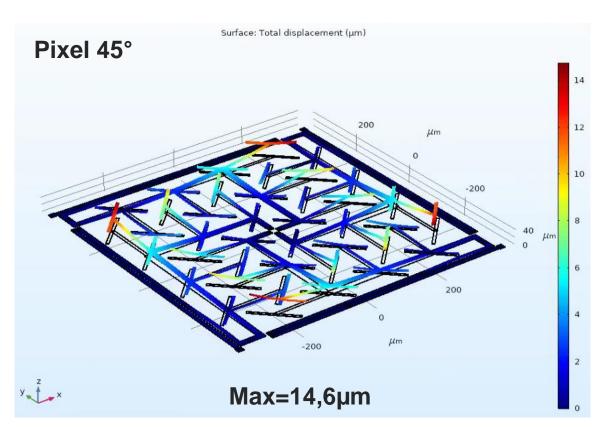


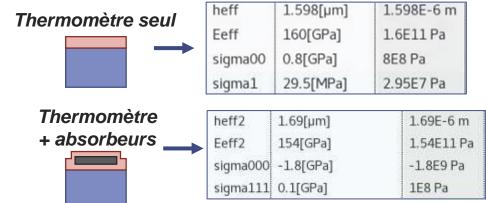
Simulations mécaniques



Simulation mécanique à température ambiante du stress total généré dans l'empilement technologique du pixel lors de la fabrication:

- La couche de TiN en forte compression dans les dipôles absorbeurs augmente le stress total et induit une forte déflection des spirales des bolomètres actifs.
- En fonctionnement à froid, on attend une réduction de cette déformation de 20 à 30% par rapport à la température ambiante.

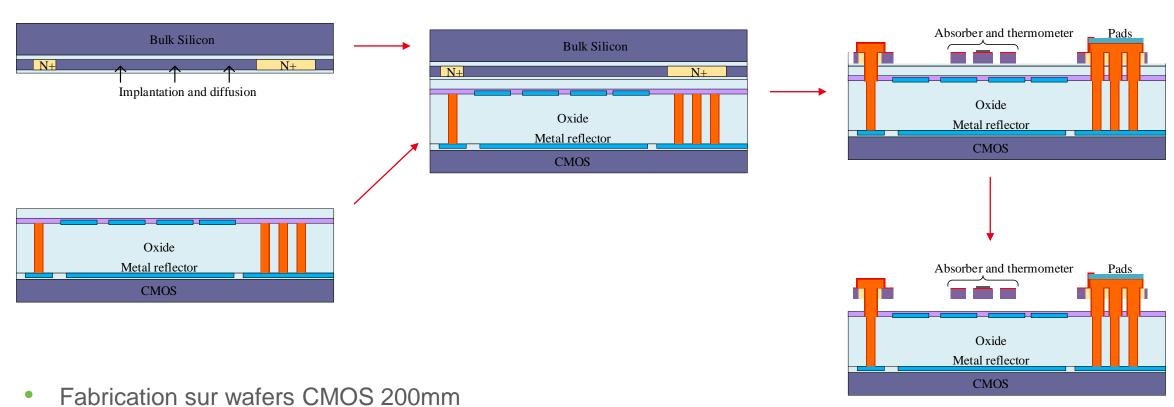






Fabrication





- Environ 150 étapes technologiques

Perspectives



- Le projet BBOP350 vise à concevoir et fabriquer des matrices de détecteurs polarimétriques pour la bande 300-500 μm réutilisant les briques technologiques développées pour BBOP / SPICA.
- Ces détecteurs intégreront pour la première fois des Surfaces Haute Impédance permettant de conserver une intégration Above-IC pour les grandes longueurs d'onde.
- Les **spécifications sont définies pour une application au sol** pour un instrument type ArTéMiS dans la perspective d'une démonstration sur le ciel.
- La phase de conception est terminée: absorption optique, optimisation des thermomètres, mécanique.
- Les travaux en cours portent sur la conception des masques de fabrication.

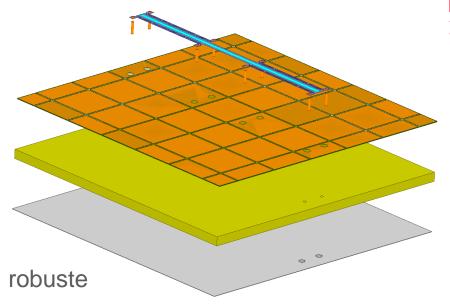
Perspectives

Pixels développés pour des applications non refroidies à 400 GHz et 650 GHz (thèse A. Fournol, CEA-DGA)

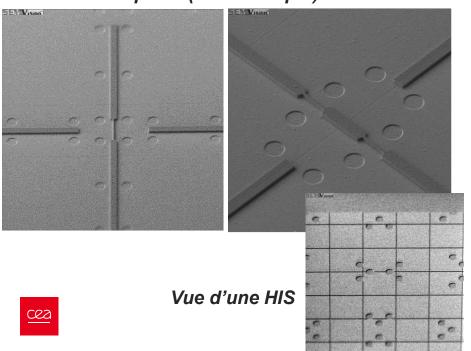
Performances similaires avec bande d'absorption ~30%

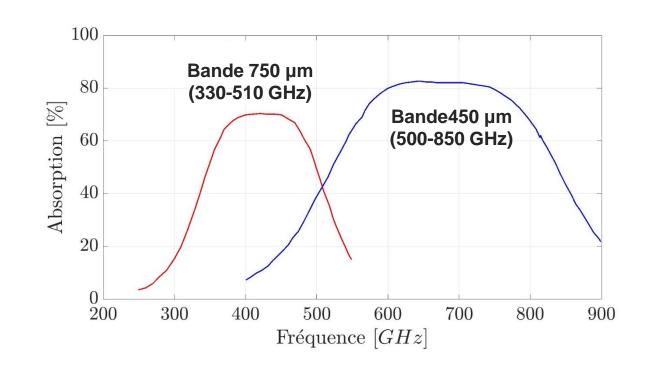
Pour aller vers les λ millimétriques:

■ Besoin d'un gap sub-µm entre patchs => limites pour une fabrication robuste

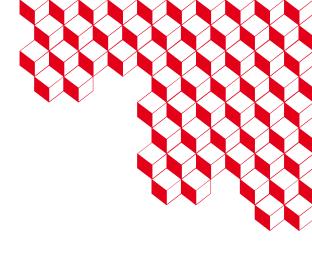


Vues de dipôles (bande 750µm)









Merci

CEA-Leti, Grenoble, France

cea-leti.com







